

## トランジスタ

## 2SC2076

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

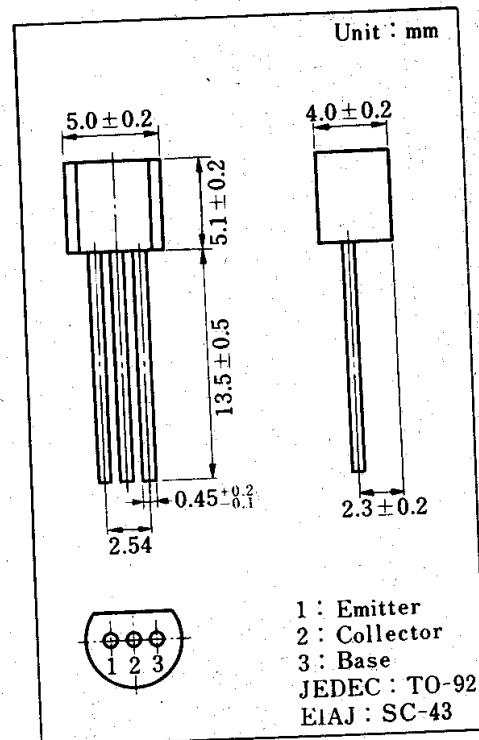
高周波増幅用 / RF Amplifier

## ■ 特徴 / Features

- AM/FM ラジオの RF 増幅, 発振, 混合, IF に最適です。  
Suitable for RF amp., OSC, mix. and IF amp. in FM/AM radios.
- サージ破壊強度が大きい。 / Large with standing capability against surge voltage.

## ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CBO</sub>	35	V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO</sub>	30	V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EBO</sub>	4	V
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	20	mA
コレクタ損失	P <sub>C</sub>	400	mW
接合部温度	T <sub>J</sub>	150	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-55 ~ +150	°C



## ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> = 20 V, I <sub>E</sub> = 0			1	μA
コレクタ・ベース電圧	V <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> = 10 μA, I <sub>E</sub> = 0	35			V
コレクタ・エミッタ電圧	V <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> = 2 mA, I <sub>B</sub> = 0	30			V
エミッタ・ベース電圧	V <sub>EBO</sub>	I <sub>E</sub> = 10 μA, I <sub>C</sub> = 0	4			V
直流電流増幅率	h <sub>FE</sub> *	V <sub>CE</sub> = 10 V, I <sub>C</sub> = 1 mA	80		360	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = 10 mA, I <sub>B</sub> = 1 mA			0.4	V
トランジション周波数	f <sub>T</sub>	V <sub>CB</sub> = 10 V, I <sub>E</sub> = -1 mA	80		200	MHz
コレクタ出力容量	C <sub>ob</sub>	V <sub>CB</sub> = 10 V, I <sub>E</sub> = 0, f = 1 MHz			3.5	pF
雑音指数	NF	V <sub>CB</sub> = 10 V, I <sub>E</sub> = -1 mA, f = 100 MHz			5	dB

\* h<sub>FE</sub> ランク分類 / h<sub>FE</sub> Classifications

Class	B	C	D
h <sub>FE</sub>	80 ~ 160	120 ~ 240	180 ~ 360